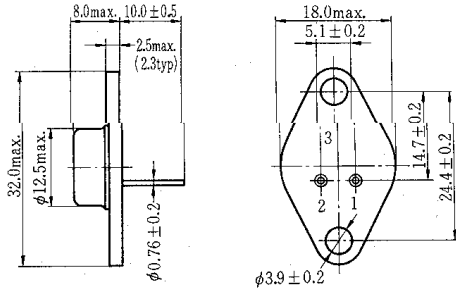


2SA566H

シリコン PNP エピタキシャル形
中電力スイッチング用

SILICON PNP EPITAXIAL
MEDIUM POWER SWITCHING



1. ベース: Base
2. エミッタ: Emitter
3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
(Dimensions in mm)

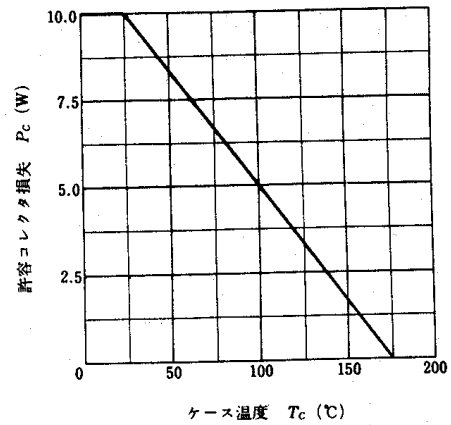
(JEDEC TO-66MOD.)

■ 最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SA566H	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-100	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-4	V
コレクタ電流	I_c	-0.7	A
許容コレクタ損失	P_c^*	10	W
接合部温度	T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値
* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_c=-1\text{mA}, I_E=0$	-100	-	-	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_c=-5\text{mA}, R_{BE}=\infty$	-100	-	-	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-5\text{mA}, I_c=0$	-4	-	-	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$	-	-	-10	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-3\text{V}, I_c=0$	-	-	-10	μA
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE}=-4\text{V}, I_c=-50\text{mA}$	35	-	200	
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=-4\text{V}, I_c=-400\text{mA}$	20	-	-	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-4\text{V}, I_c=-50\text{mA}$	-	-	-1.0	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_c=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$	-	-	-1.5	V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	25	-	pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-4\text{V}, I_c=-30\text{mA}$	-	100	-	MHz
ターンオン時間	t_{on}	$V_{CC}=-10.3\text{V},$ $I_c=10I_{B1}=-10I_{B2}=-200\text{mA}$	-	0.2	-	μs
ターンオフ時間	t_{off}		-	0.25	-	μs
蓄積時間	t_{sig}		-	0.15	-	μs

* 2SA566H は h_{FE} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。
* The 2SA566H is grouped by h_{FE} as follows.

①	②	③
35~70	60~120	100~200